(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-110957

(43)公開日 平成5年(1993)4月30日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

H 0 4 N 5/335

V 8838-5C

審査請求 未請求 請求項の数4(全 11 頁)

(21)出願番号 特願平3-271009

(22)出願日 平成3年(1991)10月18日 (71)出願人 000000376

オリンパス光学工業株式会社

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号

(72)発明者 柳舘 昌春

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリ

ンパス光学工業株式会社内

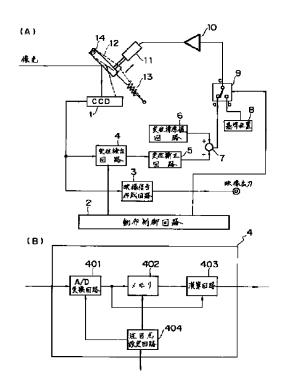
(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54) 【発明の名称】 撮像装置

(57) 【要約】

【目的】光学的に結像面を変位させて高解像度の撮像画 像を得る撮像装置に於いて、安価な構成で変位を正確に 行うこと。

【構成】被写体からの放射光を反射して電荷結合素子 (CCD) に導く反射ミラー12は、変位標準値回路6 及び基準位置回路8の出力に応じて揺動し、CCD1結 像面に結像される像位置を所定量変位させる。この像位 置の変位は、CCD1の出力より変位検出回路4にて検 出され、その結果に応じて変位補正回路5は上記像位置 の変位量が正確に上記所定量となるような補正値を出力 し、加算回路7にて上記変位標準値回路6の出力と加算 される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被写体からの放射光を集光する光学系 と、

前記集光光を反射する反射ミラーと、

前記反射ミラーにより反射された集光光を検知する固体 撮像素子と、

前記反射ミラーを変位させることにより、前記集光光の 前記固体撮像素子面に結像された像位置を所定量変位さ せる像変位手段と、

素子の出力より検出する像変位検出手段と、

前記固体撮像素子面での像位置を正確に前記所定量変位 させるように、前記像変位検出手段の出力に応じて前記 像変位手段を校正する校正手段と、

を具備することを特徴とする撮像装置。

前記像変位手段は前記反射ミラーによる 【請求項2】 像位置の変位を一定周期で行わせ、

前記反射ミラーはバネにより保持されていることを特徴 とする請求項1に記載の撮像装置。

【請求項3】 被写体からの放射光を集光する光学系 20

前記集光光を反射する反射ミラーと、

前記反射ミラーにより反射された集光光を検知する固体 撮像素子と、

前記反射ミラーを変位させることにより、前記集光光の 前記固体撮像素子面に結像された像位置を変位させるミ ラー変位手段と、

前記反射ミラーの変位量を測定するミラー変位検出手段

撮像素子面に結像された像位置を所定量変位させるよう に前記ミラー変位手段を駆動する駆動手段と、

前記固体撮像素子面での像位置の変位を、前記固体撮像 素子の出力より検出する像変位検出手段と、

前記固体撮像素子面での像位置の変位が正確に前記所定 量となるように、前記像変位検出手段の出力に応じて前 記ミラー変位検出手段を校正する校正手段と、

を具備することを特徴とする撮像装置。

【請求項4】 前記像変位検出手段は、前記固体撮像素 子の出力よりその一部を注目範囲として検出する注目範 40 えることを特徴としている。 囲設定手段と、

前記注目範囲設定手段により検出された前記注目範囲の 画素出力の変化より、前記反射ミラーの変位による前記 像位置の変化量を検出する変化量検出手段と、

より構成されることを特徴とする請求項1乃至3に記載 の撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、二次元の固体撮像素子 を用いた撮像装置に係り、特に、素子数の小さい二次元 50 変位量を調整することにより、メカニカル駆動部の温度

の固体撮像素子を用いた場合に於いても高解像度の撮像 画像が得られるようにした撮像装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、二次元の固体撮像素子を用い た撮像装置に於いては、素子数の小さい二次元の固体撮 像素子を用いた場合でも、高解像度の撮像画像が得られ るようにすることが望まれており、このような目的を達 成するために、種々の試みがなされている。

【0003】例えば、特開昭59-13476号公報に 前記固体撮像素子面での像位置の変位を、前記固体撮像 10 は、光学的に結像面を変位させ、変位前後の撮像出力を 合成することにより、得られる撮像出力の情報密度を上 げる手法が開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記公 報に開示されているように光学的に結像面を変位させる 方法は、一般に反射ミラー等のメカニカル駆動部が用い られるため、温度変化や経年変化等によるメカニカルな 特性の変化により、変位量が変化してしまうという問題 点を有している。

【0005】また、反射ミラーの位置を検出して上記メ カニカルな特性の変化に対応するとしても、精度の高 く、且つ温度変化や経年変化の無い変位検出機構が必要 となり、高価な装置となってしまう。

【0006】本発明は、上記の点に鑑みてなされたもの で、光学的に結像面を変位させて高解像度の撮像画像を 得ることができる安価な撮像装置を提供することを目的 としている。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため 前記反射ミラー変位検出手段の出力に応じて、前記固体 30 に、本発明の撮像装置は、被写体からの放射光を集光す る光学系と、前記集光光を反射する反射ミラーと、前記 反射ミラーにより反射された集光光を検知する固体撮像 素子と、前記反射ミラーを変位させることにより、前記 集光光の前記固体撮像素子面に結像された像位置を所定 量変位させる像変位手段と、前記固体撮像素子面での像 位置の変位を、前記固体撮像素子の出力より検出する像 変位検出手段と、前記固体撮像素子面での像位置を正確 に前記所定量変位させるように、前記像変位検出手段の 出力に応じて前記像変位手段を校正する校正手段とを備

[0008]

【作用】即ち、本発明による撮像装置では、像変位検出 手段により固体撮像素子面での像位置の変位を固体撮像 素子の出力から検出し、この検出結果に応じて、校正手 段によって、固体撮像素子面での像位置を正確に所定量 変位させるように像変位手段を校正するようにしてい

【0009】つまり、結像面の変位量を固体撮像素子の 出力より測定し、測定された変位量を基に反射ミラーの

-500-

変化や経年変化等による特性の変化に対応している。 [0010]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例を説明 する。

<第1実施例>先ず、図2の(A)及び(B)を用い て、結像面の変位による高解像度化の説明を行う。

【0011】図2の(A)は、電荷結合素子(CCD) 1の画素配置を説明するための図である。同図中、10 $1 \sim 104$ で示しているのが光電変換用のセルであり、 平方向(X)、垂直方向(Y)共に "L" である。

【0012】図2の(B)は、画素ピッチの1/2(L /2)だけX, Y両方向にCCD1を移動させた場合の 図である(同図中、破線にて移動後のセルの位置を示し てある)。

【0013】図2の(B)より明らかなように、移動後 のセルは、被写体の異なった位置を受光することとなる ため、移動前後のCCD1出力を合成、補間することに より、高解像度の撮像画像を得ることができる。

【0014】上述した説明は便宜上CCD1を変位せし めた例であるが、結像面とCCD1の関係は相対的なも のであり、結像面を画素ピッチの1/2 (L/2) だけ 変位させても同様の結果になることは容易に理解され る。そこで、本第1実施例では、結像面を光学的に変位 させ、高解像度の撮像画像を得ている。

【0015】図1の(A)は、本第1実施例の構成を示 す図である。像光は、不図示の対物レンズを通り、反射 ミラー12で反射された後、CCD1上に結像する。C CD1は、光像の明暗に応じた電気信号を、映像信号作 成回路3及び変位検出回路4に出力する。映像信号作成 30 回路3は、CCD1から入力された電気信号を合成、補 間し、高解像度の撮像画像を映像信号として出力する。

【0016】変位検出回路4は、CCD1から入力され た電気信号から、実際の結像面の変位量が、設定値であ るL/2 (画素ピッチの1/2) に対して、どの程度で あるかを測定し、変位量をL/2とするための補正値を 求めて、変位補正回路5に出力する。変位補正回路5 は、この変位検出回路4からの補正値を保持すると共 に、加算回路7に出力する。

【0017】一方、変位標準値回路6は、加算回路7に 結像面の変位量をL/2とするための標準値を出力す る。加算回路7は、この変位標準値回路6からの標準値 に変位補正回路5からの補正値を加えて、切り替え回路 9に出力する。切り替え回路9を通った信号は、パワー アンプ10を通ってボイスコイルモータ (Voice Coil M otor: VCM) 11に加えられる。

【0018】 VCM11は、パワーアンプ10により与 えられる電流量に応じて力を発生し、反射ミラー12を 変位させる。反射ミラー12はバネ13と支持部材14

に応じて像光をCCD1に反射する角度を可変する。

【0019】上記切り替え回路9のもう一方の入力に は、基準位置回路8より結像面の変位量を零とするため の設定値が与えられている。この切り替え回路9は、動 作制御回路2により、加算回路7の出力と基準位置回路 8の出力とを交互に切り替える。動作制御回路2は、そ の他、本実施例装置内の各部の動作制御を行う。

【0020】図1の(B)は、上記変位検出回路4の構 成を示す図である。CCD1からの画像情報は、A/D セル1個が1画素に対応する。隣接画素との間隔は、水 10 変換回路401によりディジタル化された後、メモリ4 02に格納されると共に演算回路403にも与えられ る。メモリ402に格納された情報は、注目点設定回路 404の指示に基づき演算回路403に適宜出力され、 そこで変位量の測定及び校正が行われる。また、メモリ 402のデータを基に注目点設定回路404が注目点の 設定を行う。注目点については後に説明を行う。

> 【0021】次に、本第1実施例の動作について説明す る。上記のような構成の装置の動作は、(1)撮像動作 と(2)変位量校正動作との2つにわけられる。

【0022】(1)撮像動作では、結像面の変位量を零 とした状態でのCCD1の出力と、結像面を水平及び垂 直方向にL/2変位させた状態でのCCD1の出力とを 映像信号作成回路3が合成,補間し、高精細画像として 出力している。そのため、反射ミラー12は、加算回路 7の出力と基準位置回路8の出力とに基づいた量だけ交 互に移動されて振動を繰り返すことにより、結像面の変 位を行っている。

【0023】即ち、結像面の変位量を零とした場合、切 り替え回路9は、基準位置回路8からの信号をパワーア ンプ10に供給する。このとき、反射ミラー12は図1 の(A)上で実線で示した位置となる。また、結像面を L/2変位させる場合、切り替え回路9は加算回路7か らの出力をパワーアンプ10に供給する。そのため、反 射ミラー12は角度を変更し、図1の(A)上で破線で 示した位置となり、結果としてCCD1上の光像がL/ 2シフトすることとなる。

【0024】(2)変位量校正動作は、撮像動作時に反 射ミラー12によるCCD1上の結像面の変位量を正確 にL/2にする動作である。即ち、本実施例装置に於い て、変位量は前記のごとく加算回路7と基準位置回路8 の出力差に対する反射ミラー12の振れ量で決まるた め、反射ミラー12のメカ機構部の特性変化の影響を直 接受けることとなる。そのため、実施例装置に於いて は、校正動作を電源投入直後、一定時間経過後、そして 反射ミラー12の周囲温度の変化が観測された場合(温 度測定は、反射ミラー12周囲に配置された温度センサ (図示せず)を動作制御回路2が監視して行っている) に行ない、変位量を一定に保つようにしている。

【0025】先ず、変位量校正動作に用いられる変位量 により支持されており、VCM11により加えられたカ50の測定方法について説明する。図3は、四角形の物体を

撮像した時のCCD1上の光量分布を示した図である。 図4の(A)は、図3の状態を真上から見た図であり、 図4の(B)は、変位量の測定での注目点での画素位置 とCCD1の出力との関係を示した図である。図4の (A) に於いて、実線及び破線で示された四角形が、変 位前後の物体の光像である。

【0026】変位量測定開始時、動作制御回路2は、注 目点設定回路404に対し動作開始指令を与え、現在撮 像している画像で変位量の測定が可能か否かを測定させ る。注目点設定回路404は、メモリ402に記憶され 10 像度の画像を得ることが可能となる。 ている現在の画像データ中に数画素間に渡って、Y方向 の変化がなく且つX方向に直線的に変化しているデータ 範囲があるか否かをチェックする。その結果、条件を満 足する範囲が画像中に存在した場合、その範囲を注目点 として検出し、変位量測定動作を開始すると共に動作制 御回路2に通知する。図4の(A)に示した注目点は、 四角形物体の右端であり、図3からわかるように、Y方 向の光量変化がなく且つX方向に直線的に変化している ため、注目点としての要求を満足している。

【0027】図4の(B)は、このような注目点中のX 20 方向の1ラインについて、X方向位置を横軸、A/D変 換回路401出力を縦軸にとった図である。同図中、X 1, X2は隣接画素であり、Z1, Z2はそれぞれシフ ト量零の時の画素X1, X2に於けるA/D変換回路4 01の出力、Z3はL/2シフト時の画素X2に於ける A/D変換回路の出力である。Z1, Z2, Z3が距離 に対して直線的になっている場合、実際のシフト量がL /2であれば、Z3 = (Z1 + Z2) / 2となる。逆 に、シフト誤差(E)は、E=K(Z3-(Z1+Z 2) /2) で得られる。

【0028】本実施例装置に於いては、変位量の測定 は、それに続く校正動作と同時に行われる。即ち、上記 シフト誤差(E)を零にするように変位補正回路 5 を校 正することにより行われている。以下、本実施例装置に 於ける変位量測定及び校正動作について具体的に説明す

【0029】変位量測定及び校正動作時、変位検出回路 4は、メモリ402より注目点のデータ(Z1, Z2) を演算回路403に取り込んだ後、動作制御回路2に要 請して切り替え回路9を切り替え、反射ミラー12を変 40 位させる。変位後の画素X2に於けるデータはZ3であ るから、演算回路403は、画素X2でのデータをA/ D変換回路401より得る毎に、上記E=K(Z3-(Z1+Z2) / 2)の演算を行い、E=0 (即ち、Z 3 = (Z1+Z2) / 2) となるように変位補正回路5 に校正信号を与えて、その変位補正回路5の出力を可変 する。反射ミラー12は変位補正回路5の出力に応じて 変位角が可変するため、Z3もそれに応じて変化する。 そして、E=0となった時、変位検出回路4は上記校正 信号出力を停止し、これにより変位補正回路5は、その 50

時の出力を校正後の変位補正回路5の出力として保持す る。これにより校正動作が終了する。上記手順により校 正が終了し、結果として、加算回路7の出力が、反射ミ

6

ラー12を、X, Y方向に正確に1/2ピッチずらす量 に校正されたこととなる。

【0030】以上のような校正終了後は、切り替え回路 9を切り替える毎に、CCD1上の光像位置が正確に1 /2ピッチ変動するため、前記の如く校正動作を適宜行 うことにより、温度変化や経年変化に影響されずに高解

<第2実施例>

【0031】次に、図5乃至図8を参照して本発明の第 2 実施例を説明する。図 5 はその構成を示す図であり、 第1実施例と同様のものには図1の(A)と同一の番号 を付してある。

【0032】本第2実施例に於いては、反射ミラー22 は、図6の(A)乃至(C)に示す如くバネ部材801 a~801dにより支持されるとともに、マグネット8 02a~802dと駆動コイル803a~803dとに より発生する力によって位置決めされている。同図の (A) は反射ミラー22及びミラー支持部材21の正面 図、(B)は側面図、(C)は反射ミラー22のX方向 への回動についての説明図である。

【0033】反射ミラー22の回動は、駆動コイル80 3a~803dに電流を流して反射ミラー22に取り付 けられたマグネット802 a~802dとの間に力を発 生させることにより行われる。例えば、X方向への回動 は、図6の(C)に示した如く駆動コイル803b,8 03 dに電流を流すことによりマグネット802b,8 02 d との間に図中垂直に走る線で示した x 方向回動中 心線を中心として反射ミラー22がX方向に回動させる 力を発生させて行われる。また、図6の(A)乃至 (C) から明らかなように、反射ミラー22は、X方向 とY方向に独立して制御される。

【0034】本第2実施例では、図5に示す如く、反射 ミラー22の位置は、LEDユニット15、反射ミラー 22、フォトディテクタユニット16により構成される 位置検出ブロックにより検出される。即ち、LEDユニ ット15から出射した光スポットは、反射ミラー22に より反射されて、フォトディテクタユニット16上に照 射される。フォトディテクタユニット16には、図7に 示すように、A、B、C、Dの4個のフォトディテクタ が取り付けられている。また、フォトディテクタユニッ ト16は、同図に示すように、反射ミラー22の揺動に より前記光スポットの移動するXY方向と各フォトディ テクタ素子の並び方向とが一致するように配置されてい る。そのため、フォトディテクタユニット16の出力に より、反射ミラー12のXY方向の変位角が検出可能と なる。

【0035】本構成をとることにより、反射ミラー12

のXY方向の位置決めが閉ループ制御で行われるため、 反射ミラー12の変位動作が高速に行われ、撮像期間の 短縮が図られている。

【0036】しかしながら、LEDユニット15の出射 光量, 反射ミラー12の反射率, フォトディテクタの出 カオフセットが変化するため、温度変化や経年変化が発 生した場合、フォトディテクタにより検出された変位角 と実際の変位角が一致しなくなることとなる。

【0037】次に、本第2実施例の動作について説明す る。本実施例装置の動作も、前述した第1実施例と同様 に、(1) 撮像動作と(2) 変位量校正動作との2つに わけられる。

【0038】(1)撮像動作に於いては、本第2実施例 も上記第1実施例と同じくCCD1の光像をX, Y方向 にそれぞれL/2ピッチずらして撮像しているが、本実 施例装置では反射ミラー12の位置制御をフォトディテ クタユニット16からの出力を基に行い、校正をCCD 1からの情報を基に行っている。

【0039】先ず、反射ミラー22が基準位置に在る 時、ディテクタ出力演算回路17は、フォトディテクタ 20 ユニット16の出力(PA~PD)より、X方向エラー 信号 (PEX= (PA+PC) - (PB+PD)) 及び Y方向エラー信号 (PEY= (PA+PB) - (PC+ PD))を作成し、加算回路7a,7bに出力してい る。スイッチ19a, 19bは共にオープンとなってお り、よって加算回路7a,7bは、ディテクタ出力演算 回路17の出力をそのまま位相補償回路20a, 20b に加える。位相補償回路20a,20bは、入力信号に 位相進みを与える回路であり、位相進みを与えられるこ とによりフォトディテクタユニット16、ディテクタ出 30 力演算回路17、加算回路7a,7b、位相補償回路2 0 a, 20b、パワーアンプ10a, 10b、反射ミラ -22で構成されるY方向及びX方向の位置決めループ が安定した位置決め状態となる。この時、反射ミラー2 2は、フォトディテクタユニット16上の光スポットが 4個のディテクタに均等にかかり(図7中に実線で示し た光スポット)、ディテクタ出力演算回路17及び加算 回路7a, 7bの出力が零となるような位置に位置決め される。

【0040】次に、反射ミラー22がシフト位置に在る 時の説明を行う。但し、動作は、X方向、Y方向とも同 じであるので、ここではY方向についてのみ行う。

【0041】即ち、シフト時、スイッチ19aは閉じて おり、加算回路7aにはY変位量設定回路18aとディ テクタ出力演算回路17の出力が加えられている。この 時、反射ミラー22は加算回路7aの出力を零とする信 号をディテクタ出力演算回路17に発生させる位置に位 置決めされる。即ち、反射ミラー22は、ディテクタ出 力演算回路17がY変位量設定回路18aの出力を打ち 消すだけのY方向エラー信号を出力する量だけ、Y方向 50 路の出力に応じて変位角が可変するため、23,26も

に回動することとなる。そして、この回動によるCCD 1上のY方向の光像の変位量がL/2となるようになっ

ている。図7に、変位量零の時のL/2の時のフォトデ ィテクタユニット16上の光スポットの位置を、破線に

て示す。

【0042】次に、(2)変位量校正動作について説明 する。変位量校正動作は、前述した第1実施例と同じ く、CCD1上での実際の結像面の変位を変位検出回路 4により検出して行う。本第2実施例では、X方向、Y 方向の2方向について校正を行うため、注目点を2点と している。X方向については、上記第1実施例と同じで あるので、Y方向について説明する。

【0043】図8の(A)に於いて、図中右下の円で囲 まれた部分がY方向注目点である。このY方向注目点 は、画像データ中に数画素間に渡って、X方向の変化が なく且つY方向に直線的に変化している範囲を指定す る。同図に示した注目点は、四角形物体の右端であり、 X方向の光量変化がなく且つY方向に直線的に変化して いるため、Y方向注目点としての要求を満足している。

【0044】図8の(B)は、Y方向注目点のY方向の 1ラインについてY方向位置を横軸に、A/D変換回路 401出力を縦軸にとった図である。同図中、Y1, Y 2は隣接画素であり、 Z4, Z5はそれぞれシフト量零 の時の画素Y1, Y2に於けるA/D変換回路401の 出力、Z6はL/2シフト時の画素Y2に於けるA/D 変換回路401の出力である。 Z4, Z5, Z6が距離 に対して直線的になっている場合、実際のシフト量がL /2であれば、Z6=(Z4+Z5)/2となる。逆 に、Y方向シフト誤差(EY)は、EY=K(Z6-(Z4+Z5)/2)で得られる。また、X方向シフト 誤差(EX)についても、前述の第1実施例と同じく、 EX=K(Z3-(Z1+Z2)/2)で得られる。ま た、変位量の測定及び校正動作は、第1実施例と同じく シフト誤差(E)を零にするように変位補正回路5を校 正することにより行われている。以下、本実施例装置に 於ける変位量測定及び校正動作について具体的に説明す

【0045】変位量測定及び校正動作時、変位検出回路 4は、メモリ402よりX方向及びY方向注目点のデー 40 夕(Z1, Z2, Z4, Z5)を演算回路403に取り 込んだ後、動作制御回路2に要請してスイッチ19a及 び19bを閉じて反射ミラー12を変位させる。変位後 の画素 X 2, Y 2 に於けるデータは Z 3, Z 6 であるか ら、演算回路403は、画素X2、Y2でのデータをA /D変換回路401より得る毎に上記EX=K(Z3-(Z1+Z2)/2) 及びEY=K (Z6-(Z4+Z))5) /2) の演算を行い、EX=0, EY=0となるよ うにX変位量設定回路18a及びY変位量設定回路18 bの出力を可変する。反射ミラー12は各変位量補正回

それに応じて変化する。そして、EX=0, EY=0となった時の各変位量設定回路の出力を、校正後の各変位量設定回路の出力として保持し、校正動作を終了する。これにより、各変位量設定回路 18a, 18bの出力は、反射ミラー12eX, Y方向に正確に1/2ピッチずらす量となるよう校正されたこととなる。

【0046】校正終了後は、スイッチ19a及び19bをON-OFFする毎に、CCD1上の光像位置が正確にL/2変動するため、温度変化や経年変化に影響されずに高解像度の画像を得ることが可能となる。

【0047】なお、本第2実施例では、XY方向のシフト量を画素ピッチの1/2とした例を用いて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、シフト量をさらに細かく1/N (N>2) とし、CCD1の出力をN回合成して画像を得ることにより、解像度をさらに高めることが可能である。

[0048]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、 光学的に結像面を変位させて高解像度の撮像画像を得る ことができる安価な撮像装置を提供することができる。 即ち、撮像素子の出力により変位量を制御しているため、変位が正確に行われると共に安価で高精細な撮像装 置の提供を可能にしている。

【図面の簡単な説明】

【図1】(A)は本発明の第1実施例の構成を示す図であり、(B)は(A)中の変位検出回路のブロック構成図である。

【図2】(A)及び(B)はそれぞれ結像面の変位による高解像度化を説明するための図で、特に(A)は電荷結合素子(CCD)の画素配置を示す図であり、(B)

10 はCCDのX, Y両方向移動前後のセルの位置関係を示す図である。

【図3】四角形の物体を撮像した時のCCD上の光量分布を示す図である。

【図4】(A)は図3の状態に於いてCCDを真上から見た場合を示す図であり、(B)は変位量の測定での注目点での画素位置とCCDの出力との関係を示す図である

【図5】本発明の第2実施例の構成を示す図である。

10 【図6】(A) は反射ミラー及びミラー支持部材の正面図、(B) は側面図、(C) は反射ミラ22のX方向への回動を説明するための斜視図である。

【図7】図5中のフォトディテクタユニットの構成を示す正面図である。

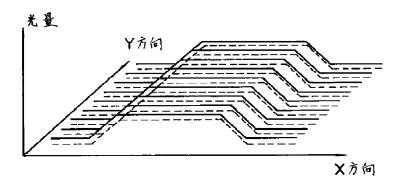
【図8】(A)は四角形の物体を撮像した時のCCDを 真上から見た場合を示す図であり、(B)はY方向注目 点のY方向の1ラインについて画素位置とCCDの出力 との関係を示す図である。

【符号の説明】

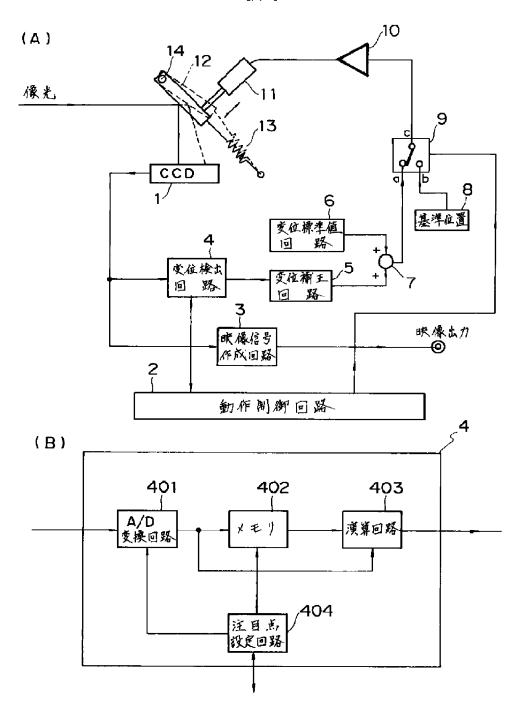
20 1…電荷結合素子(CCD)、2…動作制御回路、4…変位検出回路、5…変位補正回路、6…変位標準値回路、7,7a,7b…加算回路、8…基準位置回路、9…切り替え回路、12,22…反射ミラー、13…バネ、16…フォトディテクタユニット、17…ディテクタ出力演算回路、18a…X変位量設定回路、18b…Y変位量設定回路、19a,19b…スイッチ、20a,20b…位相補償回路、21…ミラー支持部材、401…A/D変換回路、402…メモリ、403…演算回路、404…注目点設定回路。

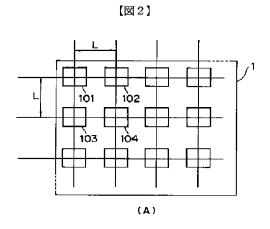
【図3】

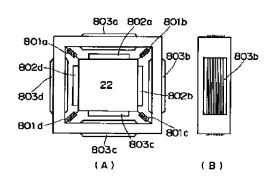
30



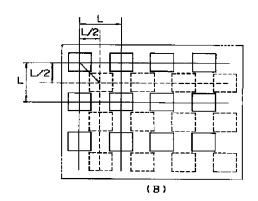
【図1】

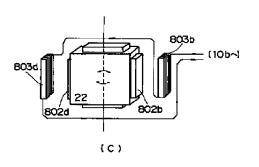


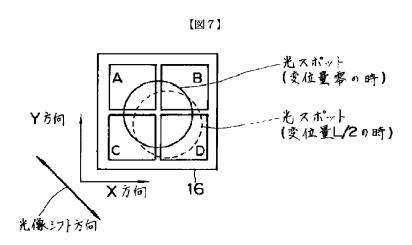




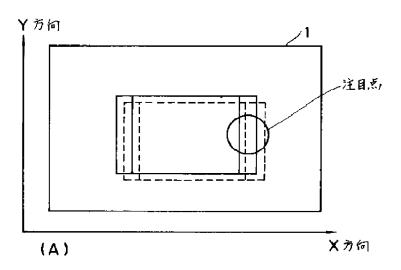
【図6】

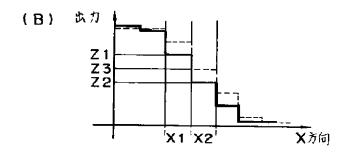




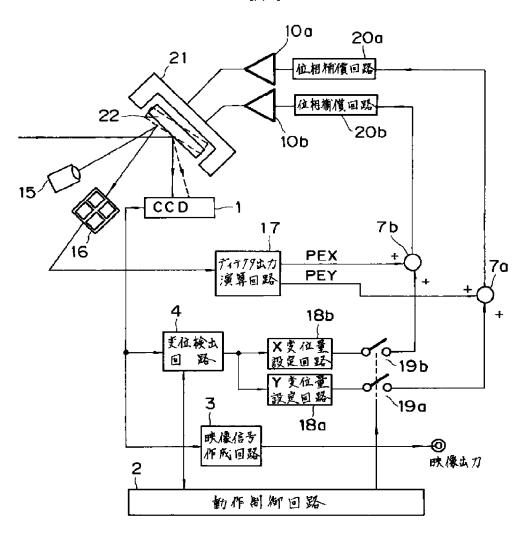


【図4】

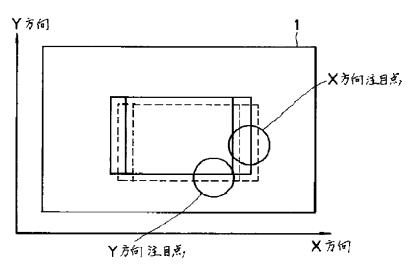




【図5】



【図8】



(A)

